07.2

Параметрическое усиление излучения квантово-каскадного лазера на длине волны 4.6 µm в нелинейном кристалле ZnGeP₂

© О.Б. Выскубенко^{1,2}, С.Г. Гаранин¹, Н.Г. Захаров^{1,2}, К.В. Кусакина^{1,3}, В.И. Лазаренко^{1,2}, А. Мухин¹, Г.С. Соколовский⁴, К.А. Туляков^{1,3}

¹ Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, Саров, Нижегородская обл., Россия

² Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия

³ Филиал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в городе Сарове, Саров, Нижегородская обл., Россия

⁴ Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия E-mail: gs@mail.ioffe.ru

Поступило в Редакцию 14 июля 2023 г. В окончательной редакции 21 сентября 2023 г. Принято к публикации 21 сентября 2023 г.

Экспериментально продемонстрировано усиление излучения импульсного квантово-каскадного лазера с длиной волны генерации $\sim 4.6\,\mu\text{m}$ за счет нелинейного преобразования в кристалле ZnGeP₂. Пиковая мощность на выходе нелинейного кристалла составила 373 W при входной пиковой мощности квантово-каскадного лазера 0.4 W.

Ключевые слова: квантово-каскадный лазер, Но:YAG-лазер, параметрическое нелинейное преобразование.

DOI: 10.61011/PJTF.2023.21.56464.19686

Одно из окон прозрачности атмосферы приходится на спектральную область $4.5-5.2 \,\mu$ m, что вызывает интерес к разработке лазеров, излучающих в этом диапазоне длин волн. Одним из таких источников излучения являются квантово-каскадные лазеры (ККЛ), которые благодаря своей униполярности и независимости от межзонных переходов способны излучать в среднем и дальнем ИК-диапазонах. Это делает их привлекательными для использования в экологическом мониторинге [1], неинвазивной медицинской диагностике [2], дистанционном зондировании [3] и построении беспроводных оптических систем связи [4].

Существенный прогресс в технологии создания ККЛ привел к значительному увеличению их выходной мощности. Так, сообщается о достижении на длине волны 4.5-4.6 µm выходной мощности свыше 10 W в импульсном режиме при комнатной температуре [5]. Тем не менее существуют труднопреодолимые ограничения на увеличение выходной мощности ККЛ. Латеральное увеличение выходной апертуры влечет за собой ухудшение качества пучка из-за многомодовой генерации, как правило не давая выигрыша в яркости. Увеличение количества каскадов в активной области приводит к увеличению рабочего напряжения и падению эффективности, а также к возникновению поперечных мод высшего порядка и ухудшению качества пучка. Увеличение тока накачки значительно выше порога генерации неизбежно приводит к росту падения напряжения на активной зоне ККЛ, что в свою очередь влечет за собой рассогласование лазерных и инжекционных уровней квантовых каскадов и препятствует повышению выходной мощности.

В литературе представлено несколько способов увеличения выходной мощности систем ККЛ. В частности, интересна монолитная комбинация задающего генератора с усилителем в конфигурации MOPA (master oscillator power amplifier) [6,7], применяемая чаще всего для повышения мощности ККЛ с распределенной обратной связью, поддерживающих одночастотный режим генерации. Излучение массива синхронизованных по фазе ККЛ может давать пиковую мощность импульса в несколько десятков ватт [8,9]. Так, массив из ста ККЛ обеспечил генерацию с центральной длиной волны 4.76 µm и пиковой мощностью в 40 W [8]. Сравнительно невысокая эффективность массива с трехзначным количеством элементов по сравнению с одиночным излучателем [5] в первую очередь определяется усложнением отвода тепла от чипа при повышении мощности. Кроме того, при сложении излучения отдельных элементов может возникать деструктивная интерференция, снижающая общую эффективность массива. Однако в работе [8] измерения дальнего поля подтвердили, что даже при больших токах накачки более 73.3% мощности излучения содержалось в центральном пятне, что является впечатляющим результатом.

Более простым с точки зрения технической реализации способом получения высокой мощности в импульсном режиме может быть параметрическое усиление излучения ККЛ. Так, в работе [10] сообщается о получении пиковой мощности в 580 W от ККЛ с распределенной обратной связью, генерирующего в непрерывном ре-



Рис. 1. *а* — ватт-амперная характеристика ККЛ. Точкой на кривой обозначена рабочая точка лазера. *b* — осциллограмма импульса излучения ККЛ (*1*) и импульса запускающего генератора (*2*). *с* — схема экспериментальной установки.

жиме 3 mW (усиление 53 dB) на длине волны $4.5 \,\mu$ m. В качестве накачки использовался импульсный Ho:YAGлазер, генерирующий импульсы длительностью 30 ns с частотой 20 kHz на длине волны $2.09\,\mu$ m. В качестве нелинейного кристалла использовался периодически поляризованный нелинейный элемент OP-GaAs длиной 41 mm. Кроме того, о параметрическом усилении излучения ККЛ в спектральном диапазоне $8-10\,\mu$ m сообщается в работах [11,12], где достигнуто максимальное усиление 20.5 dB (в 111 раз) и 26 dB соответственно.

В настоящей работе приводятся результаты экспериментов по усилению излучения ККЛ на длине волны $\lambda \approx 4.6 \,\mu\text{m}$ с помощью параметрического преобразования в нелинейном кристалле ZnGeP₂. Для параметрического преобразования были использованы квантовокаскадный лазер (усиливаемое излучение) и Ho:YAGлазер накачки. Оба источника работали в импульснопериодическом режиме с частотой 10 kHz, что потребовало решения задачи синхронизации усиливаемого импульса и накачки во времени. Использование нелинейного кристалла ZnGeP₂, в котором достигается фазовый синхронизм без периодической поляризации, обеспечило возможность усиления многомодового излучения широкополоскового ККЛ с резонатором Фабри–Перо с широким спектром генерации. Следует отметить, что нам не удалось найти в литературе другие работы, в которых сообщалось бы об усилении излучения ККЛ с длиной волны 4.6 µm в нелинейном кристалле ZnGeP₂.

ККЛ работал вблизи порога генерации (ток накачки ККЛ составлял 1.2 пороговых значения), мощность в импульсе излучения составляла около 0.5 W (рис. 1, a) при ширине импульса около 20 ns (см. осциллограмму на рис. 1, b). Ширина спектра излучения ККЛ составляла около 18 nm с центральным пиком вблизи 4585 nm (рис. 2, a).

Для накачки использовался Ho:YAG-лазер, излучающий на длине волны 2.091 μ m ($\Delta\lambda \approx 0.5$ nm) на основной моде устойчивого резонатора ($M^2 \sim 1.1$), образованного плоским и сферическим зеркалами. Спектр его излучения приведен на рис. 2, *b*. Модуляция добротности



Рис. 2. *а* — спектр излучения ККЛ; *b* — спектр излучения Но:YAG-лазера.

резонатора осуществлялась размещенным в нем акустооптическим модулятором, что позволяло генерировать импульсно-периодическое излучение. Длительность импульса лазера накачки составляла около 20 ns по полувысоте.

Схема экспериментальной установки приведена на рис. 1, с. Излучение ККЛ, имевшее большую угловую расходимость, собиралось в параллельный пучок линзой f1 и сужалось телескопической парой f2-f3, а затем фокусировалось линзой f4 на входную грань кристалла ZnGeP₂. Кристалл имел размеры $6 \times 6 \times 15$ mm. Его оптическая ось была ориентирована по отношению к направлению излучения накачки под углом $\theta = 54.5^{\circ}$. Главная плоскость кристалла ZnGeP₂ параллельна плоскости рисунка. Поляризация ККЛ соответствовала необыкновенному лучу. Излучение накачки от Но: YAG-лазера соответствовало обыкновенному лучу и подавалось на входную грань кристалла сквозь дихроичное зеркало DM1, которое отражает излучение QCL на $\lambda \approx 4.6\,\mu\text{m}$ и пропускает излучение Но:YAG-лазера на длине волны 2.091 µm. Необходимая плотность мощности излучения накачки создается фокусировкой на входной грани кристалла с помощью линзы f 5. Подстройка фазового синхронизма осуществлялась поворотом кристалла в плоскости рисунка. После преобразования в кристалле выходной луч, имевший в составе несколько частотных компонент, отражался от двух дихроичных зеркал DM2 и DM3, чтобы отделить мощное излучение накачки на $\lambda \approx 2.1 \,\mu$ m от относительно слабого излучения на $\lambda \approx 4.6 \,\mu$ m. Для дополнительной селекции длины волны ККЛ луч подавался на дифракционную решетку DG, которая передавала фракцию $\lambda \approx 4.6 \,\mu$ m на фотодетектор PD.

Длительность усиленного импульса излучения на $\lambda \approx 4.6 \,\mu\text{m}$ составляла 6 пs. Уменьшение длительности усиленного импульса по сравнению с исходным импульсом ККЛ связано с тем, что его временной профиль определяется и исходным импульсом, и импульсом накачки. Следует учесть, что от последнего усиленный импульс зависит экспоненциально, так как усиление определяется накачкой. Это вызывает сужение временно́го профиля усиленного импульса как по сравнению с исходной формой импульса ККЛ, так и по сравнению с импульсом Ho:YAG-лазера накачки.

Средняя мощность импульса излучения длительностью 6 ns после дифракционной решетки составила 22.4 mW. При частоте следования импульсов 10 kHz это соответствует пиковой мощности 373 W. С учетом того, что пиковая мощность излучения ККЛ на входной грани нелинейного кристалла составляла 0.4 W, параметрическое усиление получилось близким к 30 dB (без учета потерь на линзах f 1-f 4).

На рис. 3 приведены теоретические и экспериментальные временные зависимости мгновенной мощности импульса излучения ККЛ, усиленного в нелинейном кристалле ZnGeP2. Расчет параметрического усиления излучения проводился с помощью программного пакета SNLO [13]. Использованная нами функция этого программного пакета осуществляет численное решение системы связанных уравнений для амплитуд напряженностей в процессе трехволнового взаимодействия. В качестве входных данных используются как данные кристалла (показатели преломления и коэффициенты поглощения, углы сноса, коэффициент нелинейности, длина кристалла), так и данные об импульсах лазера накачки и ККЛ (энергии, длительности, диаметры пучков). Как видно из рисунка, теоретические и экспериментальные значения длительности импульса усиленного излу-



Рис. 3. Теоретические и экспериментальные зависимости от времени мгновенной мощности импульса излучения ККЛ, усиленного в нелинейном кристалле.

чения неплохо согласуются и составляют ~ 8.5 и ~ 6 ns соответственно. В то же время абсолютное значение пиковой мощности импульса излучения, полученного в результате расчетов, составляет около 425 W, что примерно на 15% превосходит экспериментальное значение. Эти несоответствия объясняются, на наш взгляд, многочисленными упрощениями, присущими теоретической модели, предполагающей, что импульсы накачки и усиливаемого излучения обладают гауссовыми распределениями и идеально совпадают друг с другом во времени и пространстве.

В связи с этим есть несколько возможностей для дальнейшего увеличения параметрического усиления. Во-первых, необходимо добиться более точного согласования во времени импульсов накачки с импульсами излучения ККЛ. Оба импульса имеют ширину около 20 ns. Из-за особенностей текущей конструкции Но:YAG-лазера накачки генерация импульсов накачки происходит с неопределенностью порядка 10 ns, в то время как квантово-каскадный лазер работает значительно стабильнее (джиттер импульса ККЛ составляет менее 1 ns). В результате в нелинейном преобразовании участвует не весь импульс ККЛ, а лишь та его часть, которая перекрывается импульсом накачки, что и приводит к потерям.

Во-вторых, можно увеличить долю энергии ККЛ, участвующую в преобразовании, за счет оптимизации системы фокусировки ККЛ в нелинейный кристалл. Но:ҮАС-лазер накачки генерирует пучок, близкий к гауссову, с величиной $M^2 \approx 1.1$. Такие параметры позволяют сфокусировать излучение накачки в пучок с перетяжкой 0.7 mm, слабо расходящийся на длине нелинейного кристалла 15 mm. Квантово-каскадный лазер по своей конструкции имеет большую расходимость, причем разную по двум осям. В настоящей работе для получения коллимированного пучка использовались плоскосферические линзы, не позволяющие откорректировать эллиптическую форму сечения пучка ККЛ. Изначально большая расходимость ККЛ сохраняется при формировании перетяжки малого диаметра для сопряжения с излучением накачки в нелинейном кристалле, в результате лишь часть пучка ККЛ оказывается перекрытой и коллинеарной излучению накачки, что приводит к потерям. Для снижения этих потерь необходимо использовать цилиндрические линзы и более тщательно проектировать всю систему ввода излучения ККЛ в нелинейный кристалл в целом.

Также представляется возможным повысить выходную мощность преобразованного излучения, увеличив мощность излучения ККЛ. В настоящей работе для питания ККЛ использовался генератор тока, позволяющий работать лишь с небольшим превышением порога генерации ККЛ. Применение более мощного источника питания даст возможность значительно увеличить мощность излучения ККЛ, а следовательно, и мощность преобразованного излучения на выходе кристалла. Повышение мощности накачки тоже приведет к увеличению мощности на выходе кристалла, однако плотность мощности излучения в кристалле при этом не должна превышать порог его разрушения.

Таким образом, в ходе экспериментов по усилению излучения квантово-каскадного лазера с длиной волны $4.6\,\mu{\rm m}$ с помощью нелинейного преобразования в кристалле ZnGeP₂ пиковая мощность на выходе кристалла составила 373 W при коэффициенте усиления около 30 dB. Достигнутые результаты открывают перспективы для создания источника излучения с пиковой мощностью ~ 1 kW, основанного на параметрическом усилении узкоспектрального излучения ККЛ, что позволит значительно увеличить рабочую дальность газоанализаторов и перспективных систем оптической связи.

Финансирование работы

Работа выполнена при поддержке национального проекта "Наука и университеты" (проект FSWR-2021-012) за счет субсидии федерального бюджета на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение научно-исследовательских работ. Создание и исследование характеристик ККЛ в ФТИ им. А.Ф. Иоффе выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 21-72-30020).

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

- A. Kosterev, G. Wysocki, Y. Bakhirkin, S. So, R. Lewicki, M. Fraser, R.F. Curl, Appl. Phys. B, **90** (2), 165 (2007). DOI: 10.1007/s00340-007-2846-9
- [2] A. Schwaighofer, M. Brandstetter, B. Lendl, Chem. Soc. Rev.,
 46 (19), 5903 (2017). DOI: 10.1039/c7cs00403f
- [3] P.Q. Liu, *Mid-infrared quantum cascade lasers with novel active core and laser cavity*, PhD thesis (Princeton, 2012).
- [4] X.Pang, O. Ozolins, L. Zhang, R. Schatz, A. Udalcovs, X. Yu, S. Lourdudoss, Phys. Status Solidi A, 218 (3), 2000407 (2020). DOI: 10.1002/pssa.202000407
- [5] B.B. Дюделев, Д.A. Михайлов, А.В. Бабичев. Г.М. Савченко, C.H. Лосев, E.A. Когновицкая, A.B. Лютецкий, C.O. Слипченко, H.A. Пихтин, А.Г. Гладышев, Д.В. Денисов, И.И. Новиков, Л.Я. Карачинский, В.И. Кучинский, А.Ю. Егоров, Г.С. Соколовский, Квантовая электроника, 50 (11), 989 (2020). [V.V. Dudelev, D.A. Mikhailov, A.V. Babichev, G.M. Savchenko, S.N. Losev, E.A. Kognovitskaya, A.V. S.O. Slipchenko, N.A. Lyutetskii, Pikhtin. A.G. Gladyshev, D.V. Denisov, I.I. Novikov, L.Ya. Karachinsky, V.I. Kuchinskii, A.Yu. Egorov, G.S. Sokolovskii, Quantum Electron., 50 (11), 989 (2020). DOI: 10.1070/QEL17396].
- [6] B. Hinkov, M. Beck, E. Gini, J. Faist, Opt. Express, 21 (16), 19180 (2013). DOI: 10.1364/oe.21.019180

- M. Bertrand, A. Shlykov, M. Shahmohamadi, M. Beck,
 S. Willitsch, J. Faist, Photonics, 9 (8), 589 (2022).
 DOI: 10.3390/photonics9080589
- [8] F.-L. Yan, J.-C. Zhang, Z.-Z. Jia, N. Zhuo, S.-Q. Zhai, S.-M. Liu, F.-Q. Liu, Z.-G. Wang, AIP Adv., 6 (3), 035022 (2016). DOI: 10.1063/1.4945383
- [9] W. Zhou, D. Wu, Q.Y. Lu, S. Slivken, M. Razeghi, Sci. Rep., 8, 14866 (2018). DOI: 10.1038/s41598-018-33024-7
- [10] G. Bloom, A. Grisard, E. Lallier, C. Larat, M. Carras, X. Marcadet, Opt. Lett., 35 (4), 505 (2010). DOI: 10.1364/ol.35.000505
- [11] Q. Clément, J.-M. Melkonian, J. Barrientos-Barria, J.-B. Dherbecourt, M. Raybaut, A. Godard, Opt. Lett., 38 (20), 4046 (2013). DOI: 10.1364/ol.38.004046
- [12] F. Gutty, A. Grisard, C. Larat, D. Papillon, M. Schwarz,
 B. Gérard, R. Ostendorf, J. Wagner, E. Lallier, Adv. Opt. Technol., 6 (2), 95 (2017). DOI: 10.1515/aot-2016-0062
- [13] http://www.asphotonics.com/SNLO